



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090424000A

2010 年 1 月 14 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタマドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-MIH08 サイト製造 HPA一部製品 前処理工程 ウェーハサイズ追加変更のご案内

(認定済 41 製品への追加認定 102 製品の連絡)

(初版 PCN20090424000 2009 年 4 月 30 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	☒ Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐	-
変更内容	下記変更について認定済41製品への追加認定102製品の連絡になります。 TI-MIH08サイト製造 HPA一部製品 前処理工程 ウェーハサイズ追加変更 現行：TI-MIH08(日本) 150mmウェーハ前処理 変更後：TI-MIH08(日本) 150mm/200mmウェーハ前処理			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は4月下旬の出荷より予定しています。 2009年8月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	-			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済41製品への追加認定102製品及び200mm 33A12プロセス追加の連絡になります。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-MIH08(日本)サイト製造 一部製品について、現行 50A12/33A12 プロセス 150mmウェーハ前処理にて製造いたしておりますが、これに加え200mmウェーハ前処理での製造を追加し認定いたしました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ウェーハサイズ	150mmウェーハ	150mmウェーハ 200mmウェーハ

	現行	追加変更
TI-MIH08 50A12 プロセス	150mm ウェーハ	200mm ウェーハ
TI-MIH08 33A12 プロセス	150mm ウェーハ	200mm ウェーハ

理由：製品安定供給確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
■：追加認定品 □：認定終了品				
HPA00054ZQVR	TLV56081DW	TLV56301DWG4	TPA6020A2RGWR	TPA6203A1ZQVRG1
HPA00169DGNR	TLV56081DWG4	TLV56301PW	TPA6020A2RGWRG4	TPA6204A1DRB
HPA00177DRBR	TLV56081DWR	TLV56301PWG4	TPA6020A2RGWT	TPA6204A1DRBG4
HPA00194DGNR	TLV56081DWRG4	TLV56301PWR	TPA6020A2RGWTG4	TPA6204A1DRBR
HPA00198DRBR	TLV56081PW	TLV56301PWRG4	TPA6021A4N	TPA6204A1DRBRG4
HPA00302DRBR	TLV56081PWG4	TLV56311DW	TPA6021A4NE4	TPA6205A1DGN
HPA00360DRBR	TLV56081PWR	TLV56311DWG4	TPA6201A1DGN	TPA6205A1DGNG4
HPA00361DGNR	TLV56081PWRG4	TLV56311DWR	TPA6201A1DGNG4	TPA6205A1DGNR
HPA00379DRBR	TLV56101DW	TLV56311DWRG4	TPA6201A1DGNR	TPA6205A1DGNRG4
HPA00398DRBR	TLV56101DWG4	TLV56311PW	TPA6201A1DGNRG4	TPA6205A1DRBR
HPA00470A1DRBR	TLV56101DWR	TLV56311PWG4	TPA6201A1DRB	TPA6205A1DRBRG4
HPA00488A1ZQVR	TLV56101DWRG4	TLV56311PWR	TPA6201A1DRBG4	TPA6205A1DRBT
TLV320A1103PBSRG4	TLV56101PW	TLV56311PWRG4	TPA6201A1DRBR	TPA6205A1DRBTG4
TLV320A1110PBSRG4	TLV56101PWG4	TLV56321DW	TPA6201A1DRBRG4	TPA6205A1ZQVR
TLV320A1C1103GQER	TLV56101PWR	TLV56321DWG4	TPA6201A1GQVR	TPA6205A1ZQVRG1
TLV320A1C1103PBS	TLV56101PWRG4	TLV56321DWR	TPA6201A1ZQVR	TPA6211A1DGN
TLV320A1C1103PBSG4	TLV56101YE	TLV56321DWRG4	TPA6201A1ZQVRG1	TPA6211A1DGNG4
TLV320A1C1103PBSR	TLV56101YER	TLV56321PW	TPA6202A1ZQVR	TPA6211A1DGNR
TLV320A1C1103ZQE	TLV56101YZR	TLV56321PWG4	TPA6202A1ZQVRG1	TPA6211A1DGNRG4
TLV320A1C1103ZQER	TLV56101YZT	TLV56321PWR	TPA6203A1DGN	TPA6211A1DRB
TLV320A1C1106PW	TLV56291DW	TLV56321PWRG4	TPA6203A1DGNG4	TPA6211A1DRBG4
TLV320A1C1106PWG4	TLV56291DWG4	TPA6011A4PWP	TPA6203A1DGNR	TPA6211A1DRBR
TLV320A1C1106PWR	TLV56291DWR	TPA6011A4PWPG4	TPA6203A1DGNRG4	TPA6211A1DRBRG4
TLV320A1C1106PWRG4	TLV56291DWRG4	TPA6011A4PWPR	TPA6203A1DRB	VSP2246PFB
TLV320A1C1110GQER	TLV56291PW	TPA6011A4PWPRG4	TPA6203A1DRBG4	VSP2246PFBG4
TLV320A1C1110PBS	TLV56291PWG4	TPA6019A4PWP	TPA6203A1DRBR	VSP2246PFB
TLV320A1C1110PBSG4	TLV56291PWR	TPA6019A4PWPG4	TPA6203A1DRBRG4	VSP2246PFBG4
TLV320A1C1110PBSR	TLV56291PWRG4	TPA6019A4PWPR	TPA6203A1GQVR	
TLV320A1C1110ZQER	TLV56301DW	TPA6019A4PWPRG4	TPA6203A1ZQVR	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	TLV5630IDW	Die Size (mm):	1.910 X 3.118
Wafer Fab Site:	MIHO 8 (MIHO)	Wafer Fab Process:	50A12
Wafer Size:	200 mm	Metallization:	TiW/AICu.5
Die Protective Coating:	12KACN	-	-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Life Test	125C, 1000 Hrs	112/0	112/0	112/0
Biased Temp Humidity	85C/85%RH, 500 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240 Hrs.	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	77/0
High Temp Storage Bake	150C, 1000 Hrs.	77/0	77/0	77/0
ESD - HBM	3 units/level, 500V, 1kV, 1.5kV, 2kV	12/0	12/0	12/0
ESD - CDM	3 units/level, 500V	3/0	3/0	3/0

Note: ** Moisture preconditioning required, JEDEC L-3/260C

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Device ID:	Device1	Device2	Device3	Device4
Qual Device:	TPA6203A1DRB	TPA6205A1DRB	TPA6211A1DRBR	TLV320AIC1110
Die Size:	0.98 x 0.98 (mm)	0.98 x 0.98 (mm)	47 x 47 (mils)	79 x 102 (mils)
Wafer Fab Site:	MIHO 8 (MIHO)	MIHO 8 (MIHO)	MIHO 8 (MIHO)	MIHO 8 (MIHO)
Wafer Fab Process:	50A12	50A12	50A12	33A12
Wafer Size:	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Metallization:	TiW/AICu.5	TiW/AICu.5	TiW/AICu.5	Ti/TiN/AICu.5/TiN
Die Protective Coating:	12KACN	12KACN	12KACN	8KAOX/ 9KACN

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails			
		Device1	Device2	Device3	Device4
Manufacturability (Wafer Fab)	Per mfg. site spec	Approved	Approved	Approved	Approved
Electrical Char.	Side by side comparison	30/0	30/0	30/0	30/0